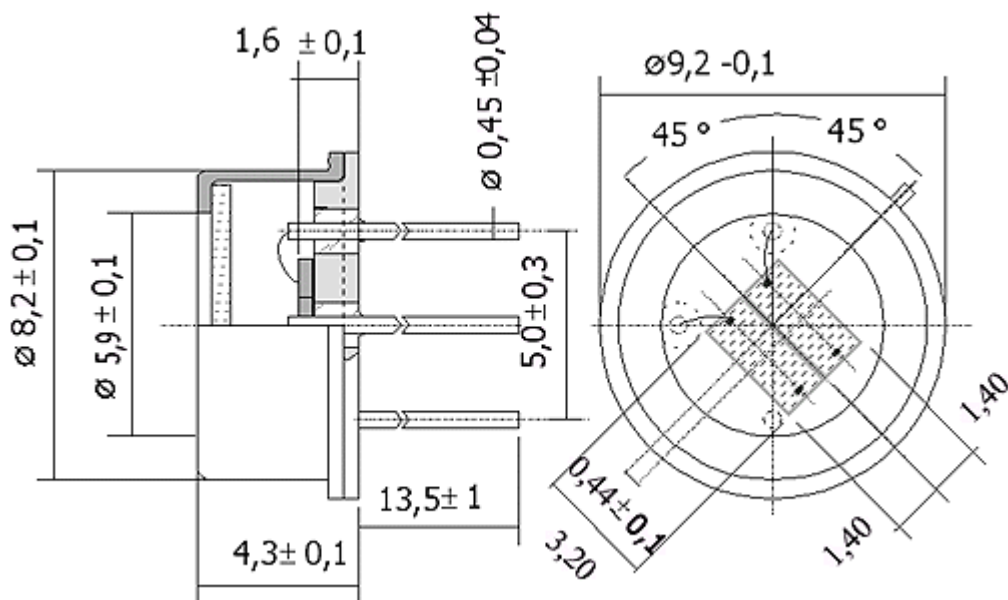


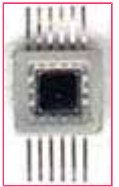


Область рабочих температур, °C	-60...+85
Эффективная фоточувствительная площадь одного элемента, мм ²	3,5
Темновой ток при U=5 В, нА	1(<10)
Фототок при U=5 В, E _γ =0.5 мВт/см ² , мкА	12(>9) <10
Разброс значений фототока, %	
Спектральный диапазон, нм	400 - 1100
Емкость при F=1 МГц, U=0 В, пФ	<55
Размер чипа, мм	2,8x3,2
Число элементов	2
Межэлементный зазор, мм	0,2

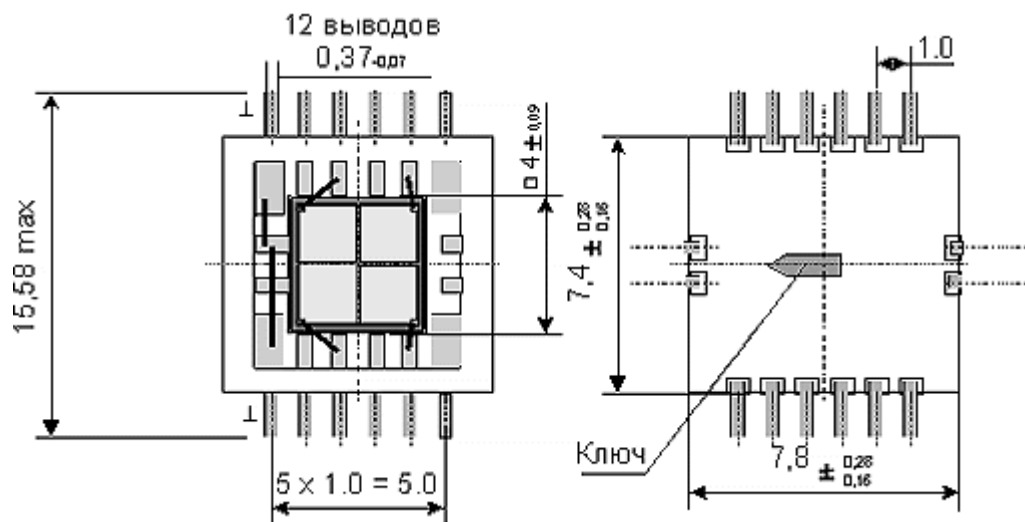


КДФМ4

КДФМ4-02



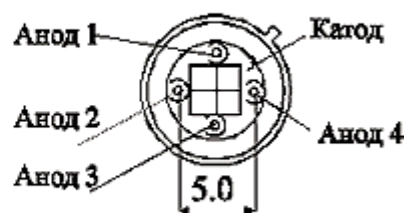
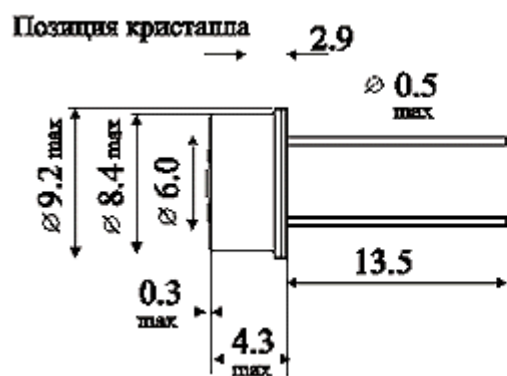
Область рабочих температур, °C	-60...+85
Эффективная фоточувствительная площадь элемента, мм ²	2,75
Темновой ток при U=5 В, нА	1 (<10)
Фототок при U=5 В, E ₃ =0.5 мВт/см ² , мкА	9 (>7)
Разброс значений фототока, %	<10
Спектральный диапазон, нм	400 - 1100
Емкость при F=1 МГц, U=0 В, пФ	<45
Размер чипа, мм	3,8x3,8
Число элементов	4
Межэлементный зазор, мм	0,1



КДФМ4-03



Область рабочих температур, °C	-60...+85
Эффективная фоточувствительная площадь элемента, мм ²	2,75
Темновой ток при U=5 В, нА	1 (<10)
Фототок при U=5 В, E ₃ =0.5 мВт/см ² , мкА	9 (>7)
Разброс значений фототока, %	<10
Спектральный диапазон, нм	400 - 1100
Емкость при F=1 МГц, U=0 В, пФ	<45
Размер чипа, мм	3,8x3,8
Число элементов	4
Межэлементный зазор, мм	0,1

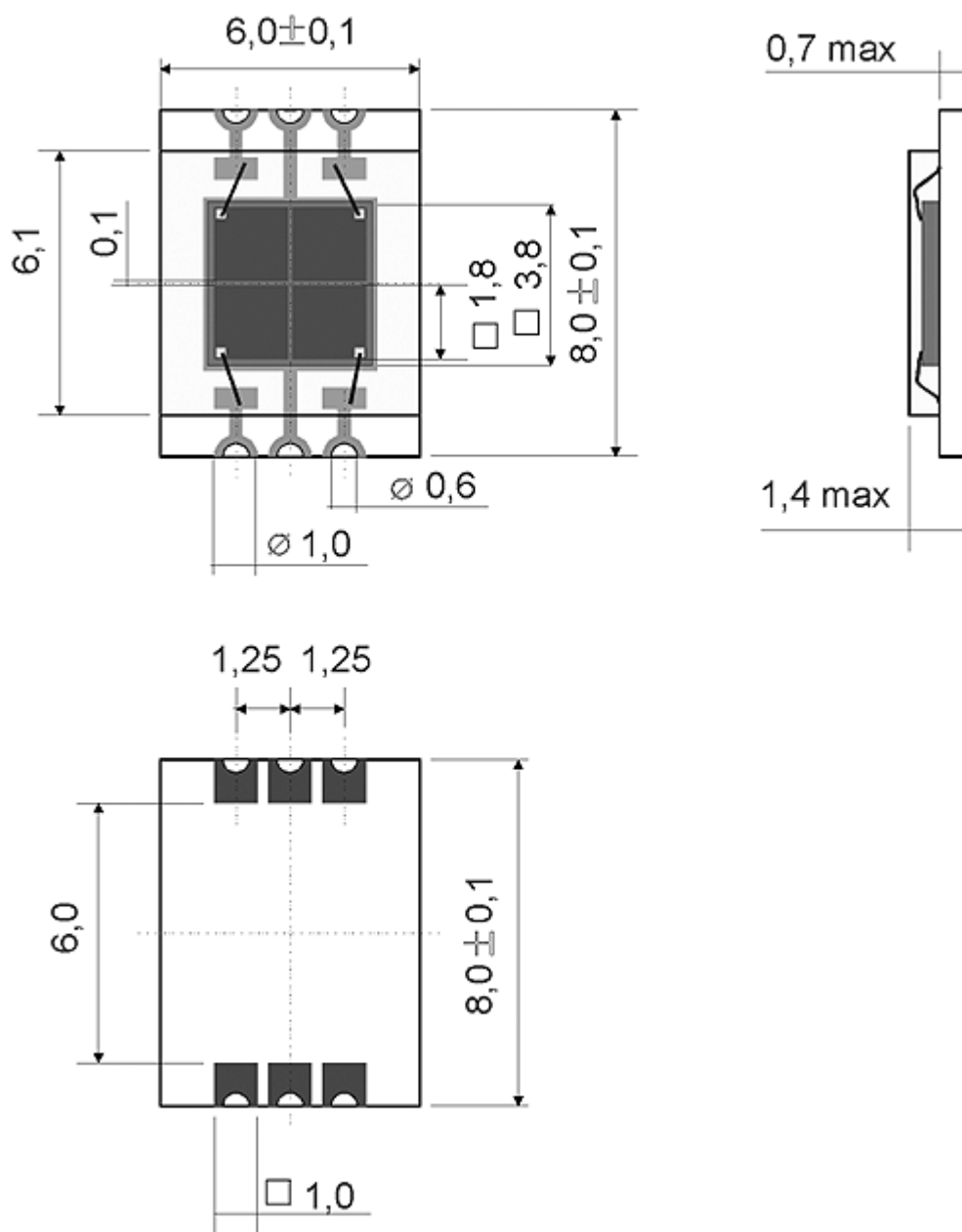


СФД4

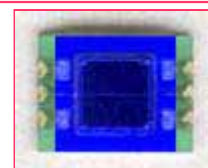
СФД4-01



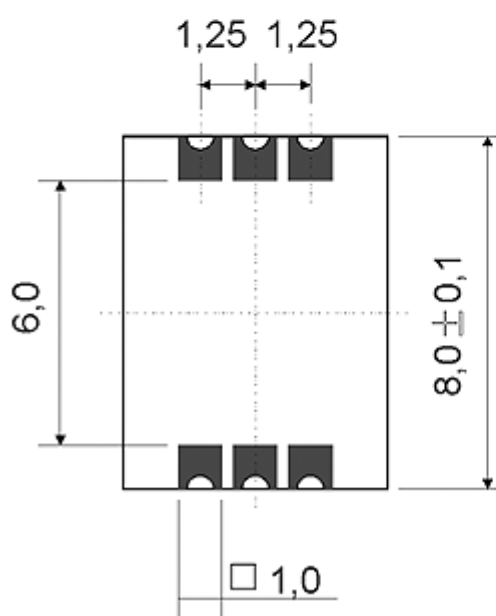
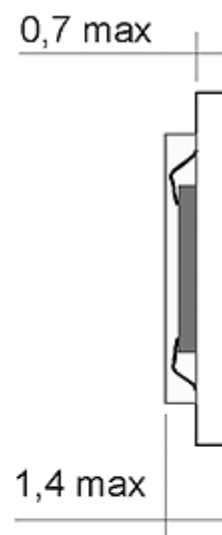
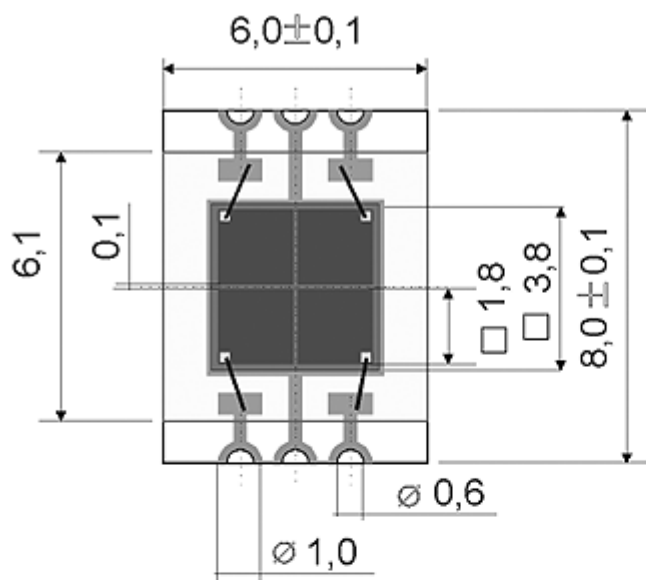
Область рабочих температур, °C	-25...+85
Эффективная фоточувствительная площадь элемента, мм ²	2,75
Темновой ток при U=5 В, нА	1(<10)
Фототок при U=0 В, E ₃ =0.5 мВт/см ² , мкА	8(>7)
Разброс значений фототока, %	<10
Спектральный диапазон, нм	400 - 1100
Емкость при F=1 МГц, U=0 В, пФ	<45
Размер чипа, мм	3,8x3,8
Число элементов	4
Межэлементный шаг, мм	0,1



СФД4-02



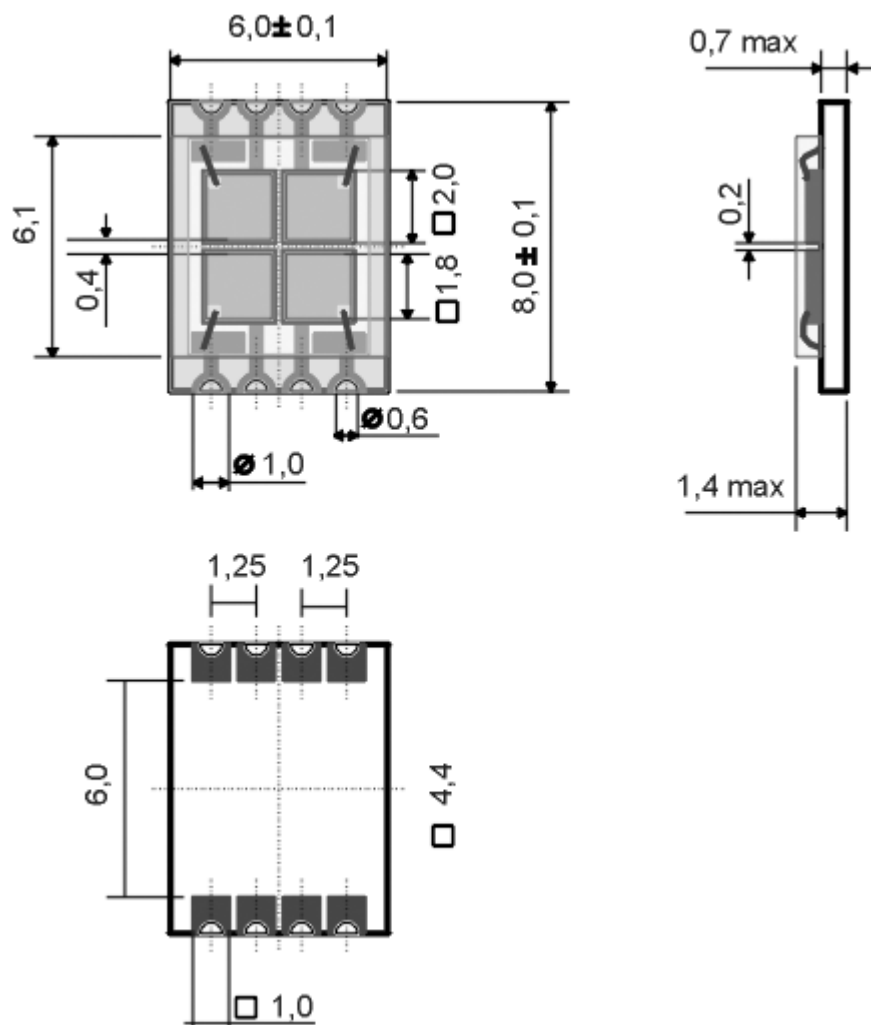
Область рабочих температур, °C	-25...+85
Эффективная фоточувствительная площадь элемента, мм ²	2,75
Темновой ток при U=5 В, нА	1(<10)
Фототок при U=0 В, E ₃ =0.5 мВт/см ² , мкА	9(>7)
Разброс значений фототока, %	<10
Спектральный диапазон, нм	700 - 1100
Емкость при F=1 МГц, U=0 В, пФ	<45
Размер чипа, мм	3,8x3,8
Число элементов	4
Межэлементный шаг, мм	0,1



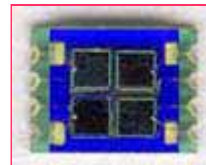
СФД4-03



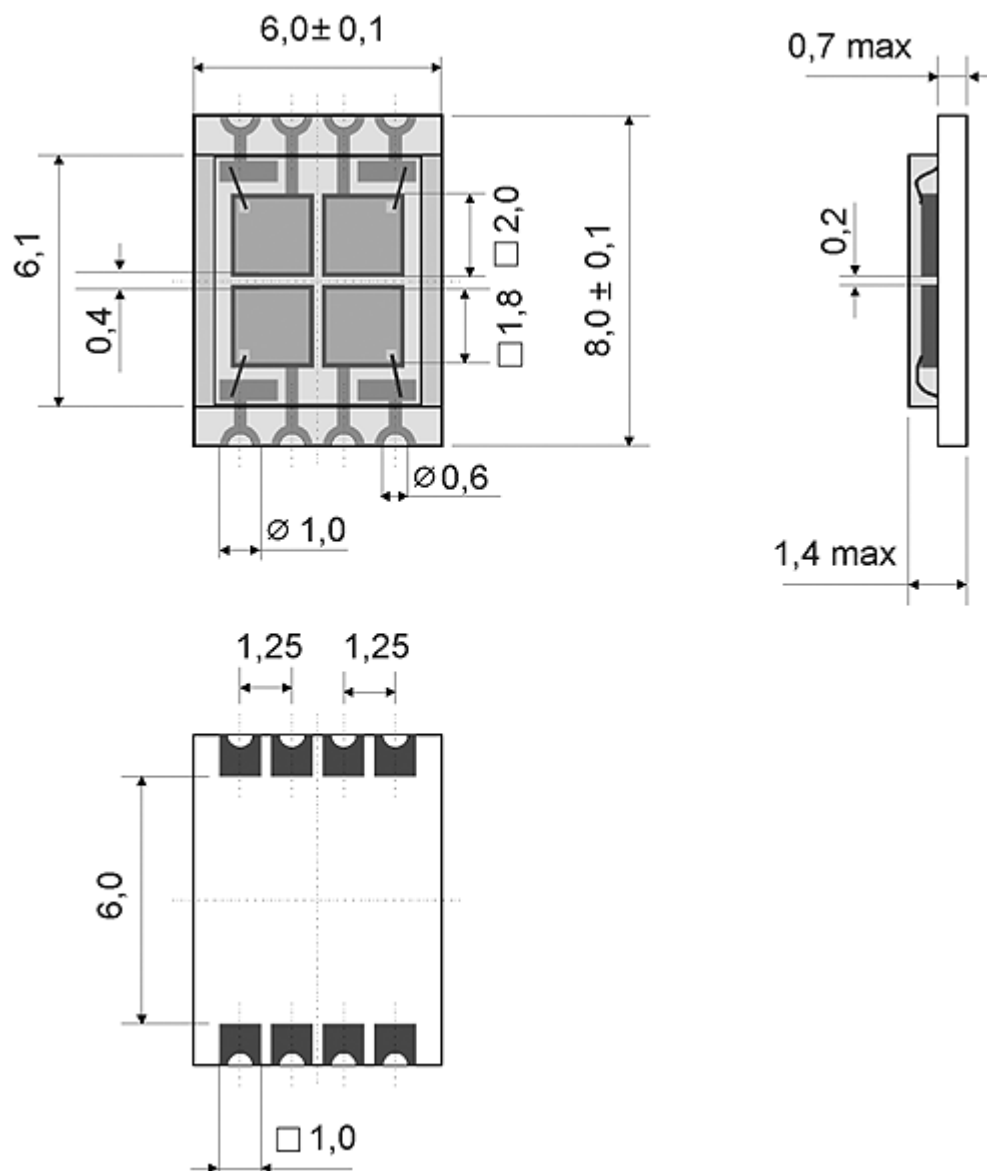
Область рабочих температур, °C	-25...+85
Эффективная фоточувствительная площадь элемента, мм ²	3,2
Темновой ток при U=5 В, нА	1(<10)
Фототок при U=0 В, E ₃ =0.5 мВт/см ² , мкА	10(>7) <10
Разброс значений фототока, %	
Спектральный диапазон, нм	400 - 1100
Емкость при F=1 МГц, U=0 В, пФ	<55
Размер чипа, мм	2,8x2,0
Число элементов	4
Межэлементный шаг, мм	0,4



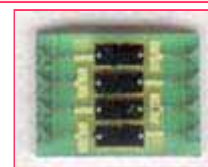
СФД4-04



Область рабочих температур, °C	-25...+85
Эффективная фоточувствительная площадь элемента, мм ²	3,2
Темновой ток при U=5 В, нА	1(<10)
Фототок при U=0 В, E ₃ =0.5 мВт/см ² , мкА	10(>7)
Разброс значений фототока, %	<10
Спектральный диапазон, нм	700 - 1100
Емкость при F=1 МГц, U=0 В, пФ	<55
Размер чипа, мм	2,0x2,0
Число элементов	4
Межэлементный шаг, мм	0,4

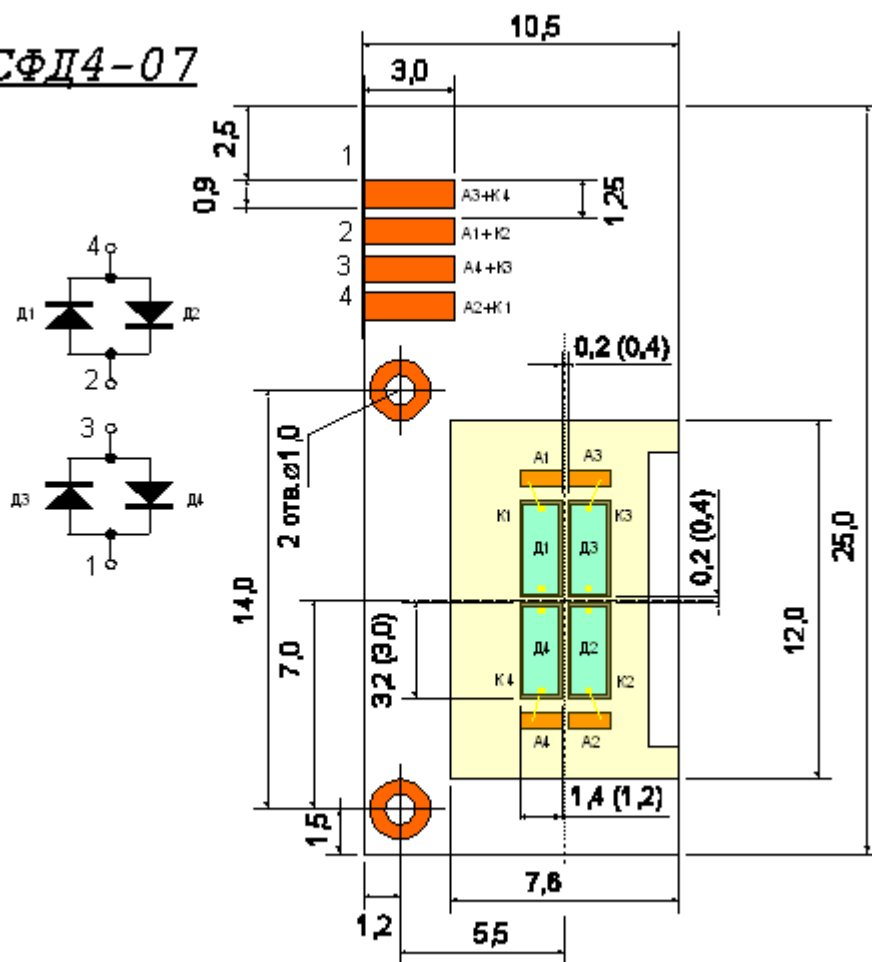


СФД4-05



Область рабочих температур, °C	-25...+85
Эффективная фоточувствительная площадь элемента, мм ²	1,6
Темновой ток при U=5 В, нА	1(<5)
Фототок при U=0 В, E ₃ =0.5 мВт/см ² , мкА	4,5(>4)
Разброс значений фототока, %	<10
Спектральный диапазон, нм	320 - 1100
Емкость при F=1 МГц, U=0 В, пФ	<25
Размер чипа, мм	2,4x1,1
Число элементов	4
Межэлементный шаг, мм	0,4

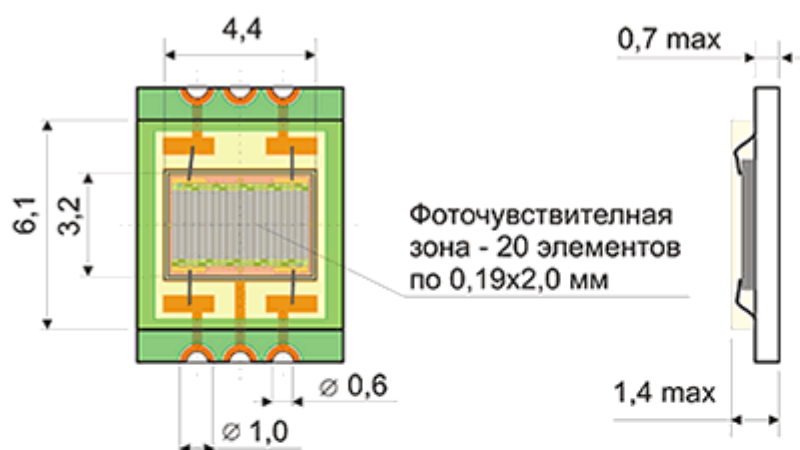
СФД4-07



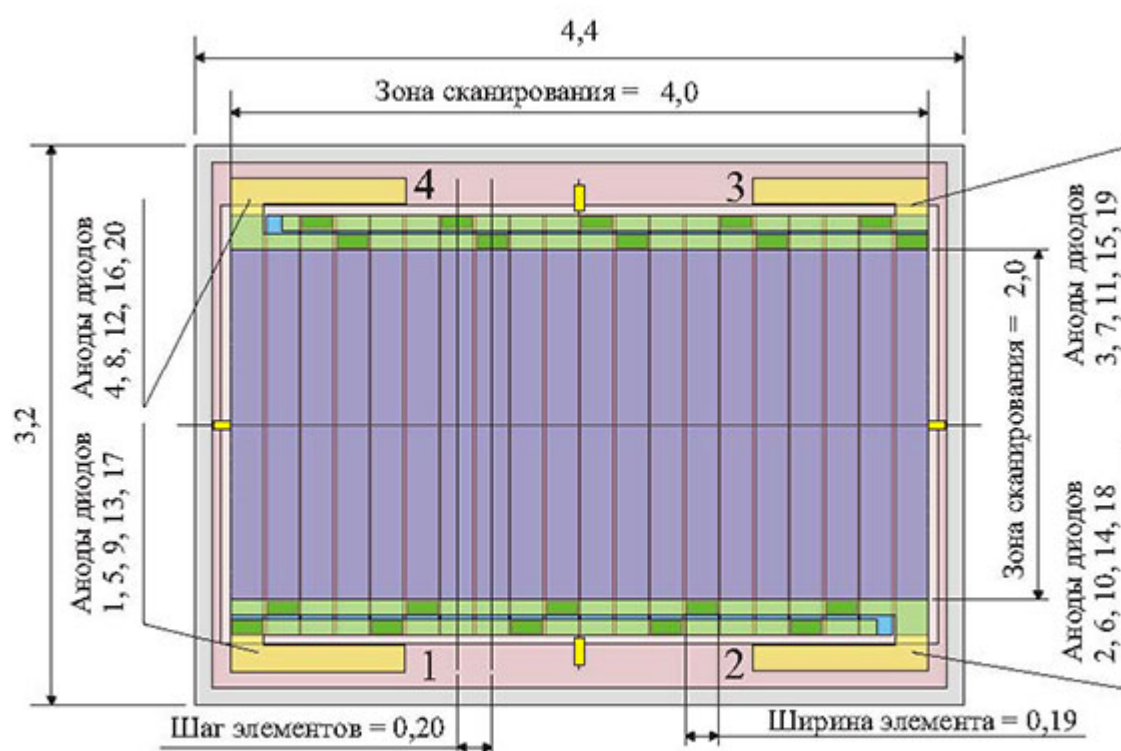
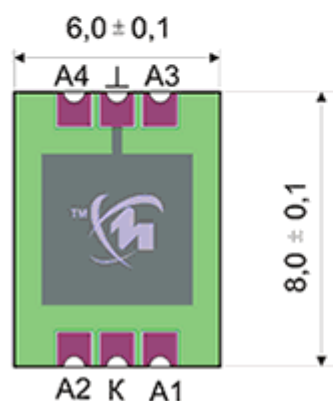
СФД4-08



Область рабочих температур, °C	-20...+85
Эффективная фоточувствительная площадь элемента, мм ²	0,38
Темновой ток при U=5 В, нА	1,0(5)
Монохроматическая чувствительность в максимуме при U=5 В, А/Вт	0,55
Фототок при U=5 В, E ₃ =0.5 мВт/см ² , мкА	5,5(>5)
Разброс значений фототока, %	<10
Спектральный диапазон, нм	350 - 1100
Емкость при F=1 МГц, U=0 В, пФ	<40
Температурный коэффициент темнового тока, п/°C	1,11
Размер чипа, мм	4,4x3,2
Размер фоточувствительного элемента, мм	0,19x2,0
Число элементов всего (и в гребенке)	20(5)
Межэлементный зазор, мм	0,01
Шаг элементов, мм	0,2
Плоский угол зрения по уровню 0,5, град	120
Габариты, мм	6x8x1,5

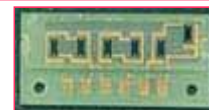


Четырехэлементная
гребенчатая
фотодиодная сборка
СФД4-08

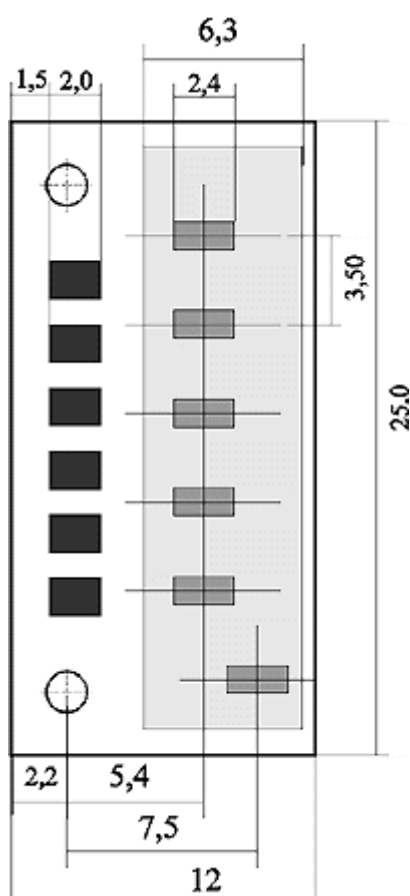


СФД6

СФД6-01

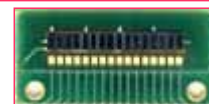


Область рабочих температур, °C	-25...+70
Эффективная фоточувствительная площадь элемента, мм ²	1,6
Темновой ток при U=5 В, нА	-
Фототок при U=0 В, E ₃ =0.5 мВт/см ² , мкА	4,5 (>4)
Разброс значений фототока, %	<15
Спектральный диапазон, нм	400 - 1100
Емкость при F=1 МГц, U=0 В, пФ	<25
Размер чипа, мм	2,4x1,1
Число элементов	6
Межэлементный шаг, мм	3,5



СФД16

СФД16-01



Область рабочих температур, °C	-25...+85
Эффективная фоточувствительная площадь элемента, мм ²	1,57
Темновой ток при U=5 В, нА	1(<5)
Фототок при U=0 В, E ₃ =0.5 мВт/см ² , мкА	4,0 (>3,5)
Разброс значений фототока, %	<10
Спектральный диапазон, нм	350 - 1100
Емкость при F=1 МГц, U=0 В, пФ	<25

Размер чипа, мм	2,3x1,05
Число элементов	16
Межэлементный шаг, мм	0,27

СФД16-01

